



X-FAB 增强其 180 纳米车规级高压 CMOS 代工解决方案

XP018 平台新增极具竞争力的第二代高压基础器件

中国北京，2024 年 5 月 20 日——全球公认的卓越的模拟/混合信号晶圆代工工厂 [X-FAB Silicon Foundries](#)（“X-FAB”）今日宣布，更新其 XP018 高压 CMOS 半导体制造平台，增加全新 40V 和 60V 高压基础器件——这些器件具有可扩展 SOA，提高运行稳健性。与上一代平台相比，此次更新的第二代高压基础器件的 R_{DSon} 阻值降低高达 50%，为某些关键应用提供更好的选择——特别适应用用在需要缩小器件尺寸并降低单位成本的系统中。

XP018 平台作为一款模块化 180 纳米高压 EPI 技术解决方案，基于低掩模数 5V 单栅极核心模块，支持 -40°C 至 175°C 的宽温度范围，并提供一系列可选的器件和模块——包括高增益双极器件、标准和高电容密度 MIM 电容器、多阈值（Vt）选项、肖特基二极管和耗尽型器件。

该平台搭载高可靠性汽车 NVM 解决方案，如嵌入式闪存（Eflash）、EEPROM 和 OTP，专为成本敏感型和稳健型汽车、工业及医疗应用而设计。

除了新推出的 40V/60V 器件外，该平台还加入了 5.3V 齐纳二极管，进一步提升其性能。此款全新低漏电流的齐纳二极管专为关键应用中的栅氧提供有效保护，如宽带隙栅极驱动器应用等。此外，其还提供一系列最高电压高达 24V 的新型隔离漏极高压器件和中阈值电压选项的 1.8V MOS 器件。

X-FAB 高压产品线经理 Tilman Metzger 表示：“我们 XP018 平台的此次升级，展现 X-FAB 致力于加强成熟技术方面的决心。XP018 平台已投产超过十年，并且仍然在汽车、工业和医疗等我们重点关注细分市场领域的新设计中得到广泛应用。这些极具竞争力的高压器件及其更新将使我们的客户能够打造更具创新性和成本效益的产品。采用全新 XP018 基础器件的设计人员可以获得 Cadence、Siemens EDA、Synopsys 等各主要 EDA 平台全面的 PDK 支持，确保在各类应用中实现无缝集成与优化。”



全新中国值标准单元库预计将于 2024 年第三季度发布。更多关于 XP018 平台的详细信息，请访问：<https://www.xfab.com/technology/high-voltage>

缩略语：

CMOS	互补金属氧化物半导体
DMOS	双扩散金属氧化物半导体
PDK	工艺设计套件
R _{DSon}	导通电阻
SOA	安全工作区
SOI	绝缘体上硅

###

关于 X-FAB：

X-FAB 是领先的模拟/混合信号和 MEMS 晶圆代工集团，生产用于汽车、工业、消费、医疗和其它应用的硅晶圆。X-FAB 采用尺寸范围从 1.0 μ m 至 110nm 的模块化 CMOS 和 SOI 工艺，及其特色 SiC 与微机电系统（MEMS）长寿命工艺，为全球客户打造最高的质量标准、卓越的制造工艺和创新的解决方案。X-FAB 的模拟数字集成电路（混合信号 IC）、传感器 MEMS 在德国、法国、马来西亚和美国的六家生产基地生产，并在全球拥有约 4,500 名员工。www.xfab.com

欢迎扫码关注 X-FAB 官方微信公众号，了解更多精彩资讯：



媒体联系：

王伟
X-FAB 中国区市场经理
86-21-2050 1645
Angela.Wang@xfab.com

乔治
GeoMatrix Public Relations Ltd.
86-10-8595 9439
george.qiao@geomatrixpr.com